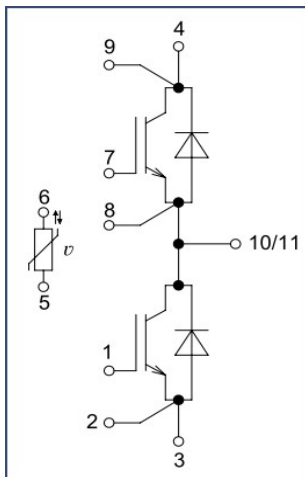
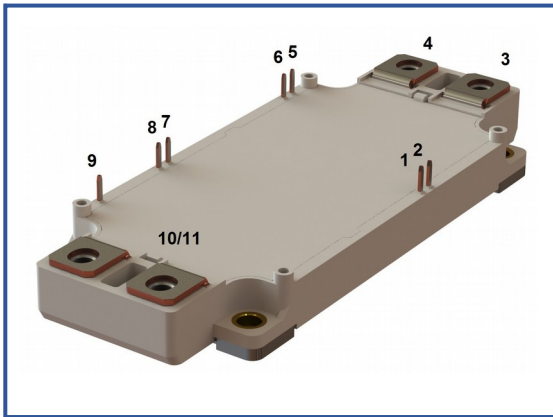


Низкоиндуктивный IGBT модуль высотой корпуса 17 мм
1700 В 300 А

Особенности чипов

- IGBT чип
 - Trench FS — V-Series IGBT (чипы Fuji 6-го поколения)
 - низкое значение $U_{CE(sat)}$
 - длительность K3 10 мкс при 150°C
 - квадратная область RBSOA при 2xI_C
- FRD чип
 - быстрое и мягкое восстановление
 - низкое падение напряжения

Особенности конструкции

- медное основание
- Al₂O₃ DBC подложки
- разварка силовых шин медной проволокой
- улучшенная стойкость к термоциклам
- соответствие RoHS
- низкое значение индуктивности

Типовые применения

- приводы двигателей переменного тока
- инверторы напряжений для солнечных панелей
- системы кондиционирования воздуха
- преобразователи высокой мощности и ИБП
- инверторы ветрогенераторов

Предельно допустимые значения параметров

Параметр	Обозн.	Условия	Знач.	Ед.
IGBT				
Напряжение коллектор-эмиттер	U_{CES}	$U_{GE} = 0.$	1700	В
Номинальный ток коллектора	$I_{C nom}$		300	А
Постоянный ток коллектора	$I_{C 25}$	$T_{vj (max)} = 175^{\circ}C; T_c = 25^{\circ}C.$	460	А
	$I_{C 80}$	$T_{vj (max)} = 175^{\circ}C; T_c = 80^{\circ}C.$	300	А
Максимальный повторяющийся импульсный ток коллектора*1	I_{CRM}	$I_{CRM} = 3 \times I_{C nom}; t_p = 1 \text{ мс.}$	900	А
Длительность импульсного тока короткого замыкания	t_{psc}	$T_{vj} = 25^{\circ}C; U_{GE} = \pm 15 \text{ В}; U_{CE} = 1000 \text{ В}; R_{G on} = R_{G off} = 3 \text{ Ом}$	10	мкс
		$T_{vj} = 150^{\circ}C; U_{GE} = \pm 15 \text{ В}; U_{CE} = 1000 \text{ В}; R_{G on} = R_{G off} = 3 \text{ Ом}$	10	
Напряжение затвор-эмиттер	U_{GES}		± 20	В
Рабочая температура в области перехода кристалла	$T_{vj (op)}$		-40...+150	°C
Диод чоппера/Обратно-параллельный диод.				
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}	$U_{GE} = 0 \text{ В.}$	1700	В
Номинальный прямой ток	$I_{F nom}$		300	А
Постоянный прямой ток	$I_{F 25}$	$T_{vj (max)} = 175^{\circ}C; T_c = 25^{\circ}C.$	352	А
	$I_{F 80}$	$T_{vj (max)} = 175^{\circ}C; T_c = 80^{\circ}C.$	300	А
Повторяющийся прямой импульсный ток*1	I_{FRM}	$I_{FRM} = 3 \times I_{F nom}; t_p = 1 \text{ мс.}$	900	А
Рабочая температура перехода	$T_{vj (op)}$		-40...+150	°C
Модуль				
Температура хранения	T_{stg}		-55...+50	°C
Напряжение пробоя изоляции	U_{isol}	AC sin 50 Гц; t = 1 мин.	4000	В

*1 Длительность импульса и частота повторения должна быть такой, чтобы температура перехода не превышала $T_{vj max}$.

Характеристики

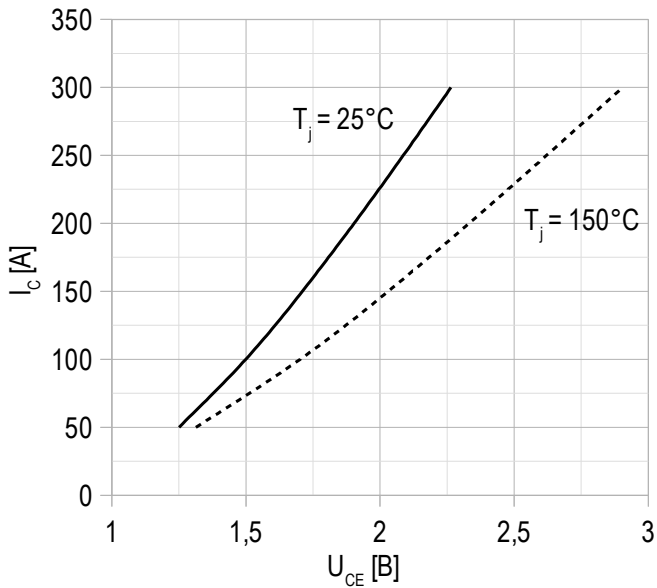
Параметр	Обозн.	Условия	Знач.			Ед.		
			мин.	тип.	макс.			
IGBT								
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	U_{CEsat}	$U_{GE} = +15\text{ V}; I_C = 300\text{ A}; t_u = 1000\text{ мкс.}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	2.16 2.77	2.21 2.87	2.42 3.14	В В	
Пороговое напряжение затвор-эмиттер	$U_{GE(th)}$	$I_C = 18\text{ mA}; U_{CE} = U_{GE}; T_{vj} = 25^\circ\text{C}; t_u = 2\text{ мс.}$		5.30	5.83	6.70	В	
Ток утечки коллектор-эмиттер	I_{CES}	$U_{CE} = 1700\text{ В}; t_u = 50\text{ мс}; U_{GE} = 0.$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	1.51 0.84	1.70 1.02	150 2.50	мкА мА	
Ток утечки затвор-эмиттер	I_{GES}	$U_{CE} = 0; U_{GE} = \pm 20\text{ V}; T_{vj} = 25^\circ\text{C}; t_u = 30\text{ мс.}$		9.50	12.1	200	нА	
Входная ёмкость	C_{ies}	$U_{CE} = 10\text{ В}; U_{GE} = 0\text{ В}; f = 1\text{ MHz}; T_{vj} = 25^\circ\text{C}.$		-	29.7	-	нФ	
Выходная ёмкость	C_{oes}			-	1.5	-	нФ	
Обратная передаточная ёмкость	C_{res}			-	2.4	-	нФ	
Заряд затвора	Q_G	$I_{Cmax} = 300\text{ A}; U_{CE} = 920\text{ В}; U_{GE} = -8 \div 15\text{ В.}$		-	3428	3550	нКл	
Встроенный резистор затвора	R_{Gint}	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}.$		-	2.5	-	Ом	
Время задержки включения	$t_{d(on)}$	$U_{CE} = 920\text{ В}; U_{GE} = \pm 15\text{ В}; I_{Cmax} = 300\text{ A}; R_G = 3\text{ Ом}; L = 100\text{ мкГн.}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	416 536	432 548	480 610	нс нс	
Время нарастания тока коллектора	t_{ri}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	60 65	63 67	75 80	нс нс	
Энергия потерь при включении	E_{on}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	39 66	42 71	51 86	мДж мДж	
Время задержки выключения	$t_{d(off)}$		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	730 900	780 930	880 1040	нс нс	
Время спада тока коллектора	t_{fi}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	452 612	476 648	560 760	нс нс	
Энергия потерь при выключении	E_{off}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	66 93	71 99	85 116	мДж мДж	
Пороговое напряжение коллектор-эмиттер	U_{CE0}		$U_{GE} = +15\text{ В}; T_{vj} = 150^\circ\text{C}; I_{CE1} = 75\text{ A}; I_{CE2} = 300\text{ A}; t_u = 1000\text{ мкс.}$		1.009	1.033	1.080	В
Динамическое сопротивление	r_{CE0}				5.73	6.11	6.68	МОм
Тепловое сопротивление переход-корпус	$R_{th(j-c)}$		$DC; I_{test} = 1.5\text{ A}; U_{GE} = +15\text{ В.}$		-	0.0761	0.0810	К/Вт
Обратно-параллельный диод.								
Постоянное прямое напряжение	U_F	$I_F = 300\text{ A}; U_{GE} = 0; t_u = 1000\text{ мкс.}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	2.08 2.38	2.13 2.46	2.33 2.71	В В	
Время обратного восстановления	t_{rr}	$U_{GE} = \pm 15\text{ В}; U_{CE} = 920\text{ В}; I_{Cmax} = 300\text{ A}; R_{Gon} = 3\text{ Ом}; L = 100\text{ мкГн.}$	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	157 288	166 370	190 480	нс нс	
Повторяющийся импульсный обратный ток	I_{rrm}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	287 328	307 352	350 400	А А	
Заряд обратного восстановления	Q_{rr}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	28.0 53.6	29.0 59.0	33.0 69.0	мкКл мкКл	
Энергия потерь при обратном восстановлении	E_{rec}		$T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	44.0 82.0	46.0 86.0	52.0 96.0	мДж мДж	
Пороговое напряжение	$U_{(TO)}$		$T_{vj} = 150^\circ\text{C}; U_{GE} = 0; t_u = 1000\text{ мкс}$		0.960	0.965	1.000	В
Динамическое сопротивление	r_T				4.71	4.97	5.54	МОм
Тепловое сопротивление переход-корпус	$R_{th(jc-D)}$	$DC; I_{test} = 1.5\text{ A}; U_{GE} = +15\text{ В.}$		-	0.14	0.15	К/Вт	

Модуль							
Сопротивление выводов	R_{Pxy}	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$.	$R_{P10/11-3}$	-	0.92	1.00	мОм
			$R_{P10/11-4}$	-	0.59	1.00	
Паразитная индуктивность модуля между силовыми выводами	L_{Pce}			-	22	-	нГн
Сопротивление термистора	R_{t25}	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 100^{\circ}\text{C}$		-	5000	-	Ом
				-	495	-	
Коэффициент температурной чувствительности	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50} (1/T_2 - 1/T_1)],$ $T_1 = 298.15 \text{ K}$		-	3375	-	к
Тепловое сопротивление корпус-основание	R_{thCH}	для модуля		-	0.009	0.014	К/Вт
Момент затягивания винтов корпуса	M_s	к охладителю М5		3	-	6	Н*м
Момент затягивания на силовых выводах	M_t	к клеммам М6		3	-	6	Н*м
Масса	W			-	360	-	г

Примечания:

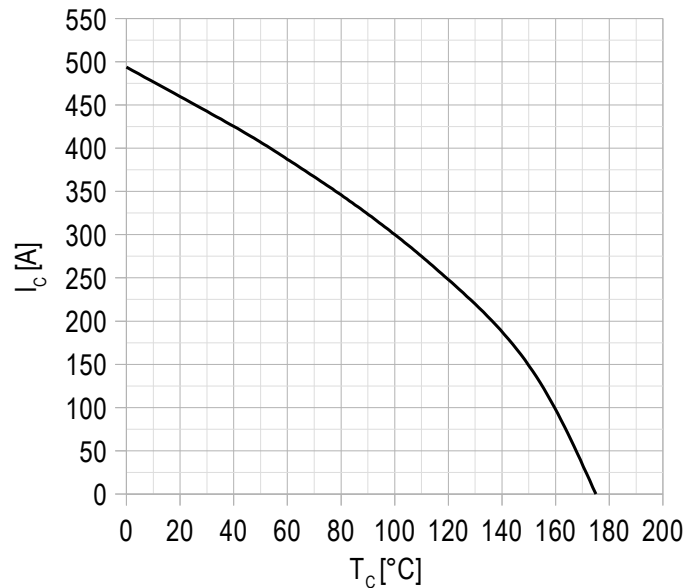
- Рабочая температура корпуса и изоляционных материалов не должна превышать $T_c = 125^{\circ}\text{C}$ макс;
- Рекомендуемая рабочая температура кристалла $T_{vj \text{ op}} = -40 \div +150^{\circ}\text{C}$;
- Данные информационные материалы являются предварительными.

Рисунок 1 – типичная выходная характеристика, IGBT.



$U_{GE} = +15\text{ V}$.

Рисунок 2 – максимальная зависимость тока коллектора от температуры кристалла.

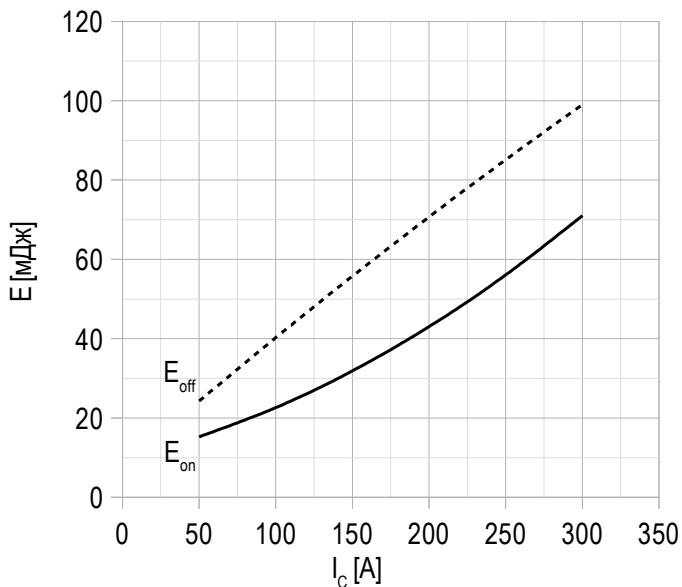


Постоянный ток;

$U_{GE} = +15\text{ V}$;

$T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C}$.

Рисунок 3 – типичная энергия переключения от тока коллектора, IGBT.



$U_{CE} = 920\text{ V}$;

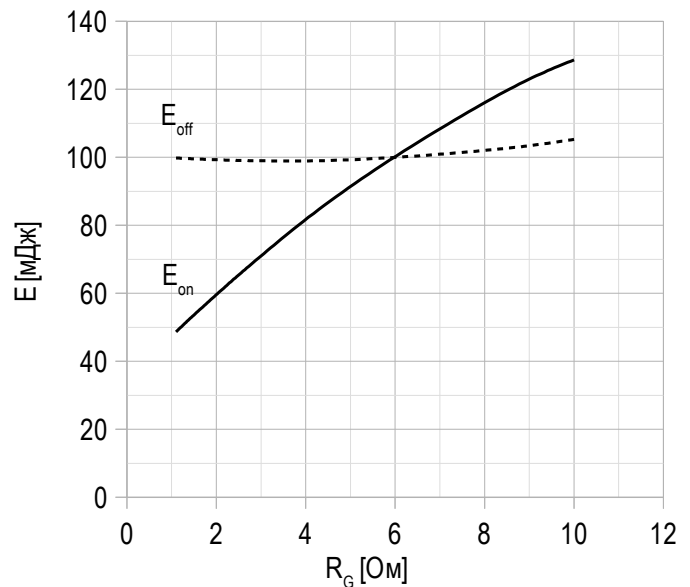
$U_{GE} = \pm 15\text{ V}$;

$R_G = 3\text{ }\Omega$;

$L = 100\text{ }\mu\text{H}$;

$T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C}$.

Рисунок 4 – типичная энергия переключения от сопротивления в затворе, IGBT.



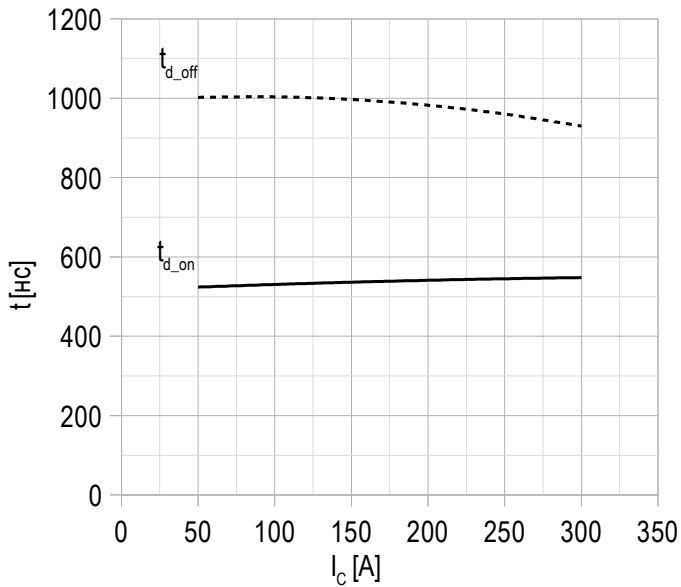
$U_{CE} = 920\text{ V}$;

$U_{GE} = \pm 15\text{ V}$;

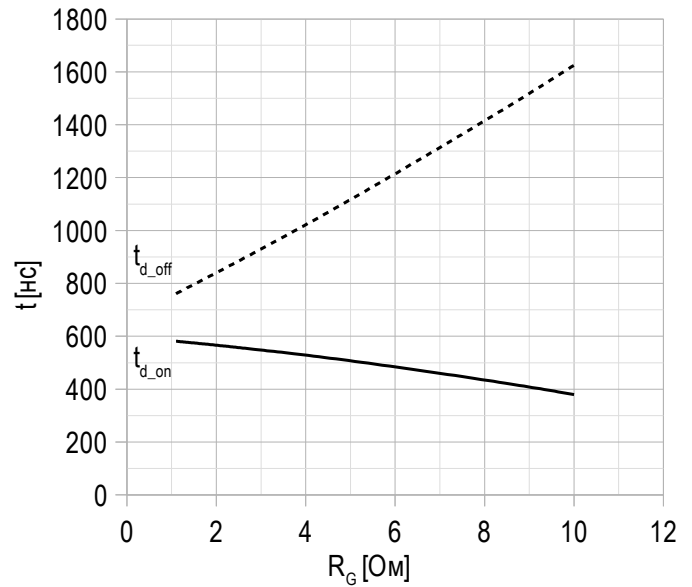
$I_{cmax} = 300\text{ A}$;

$L = 100\text{ }\mu\text{H}$;

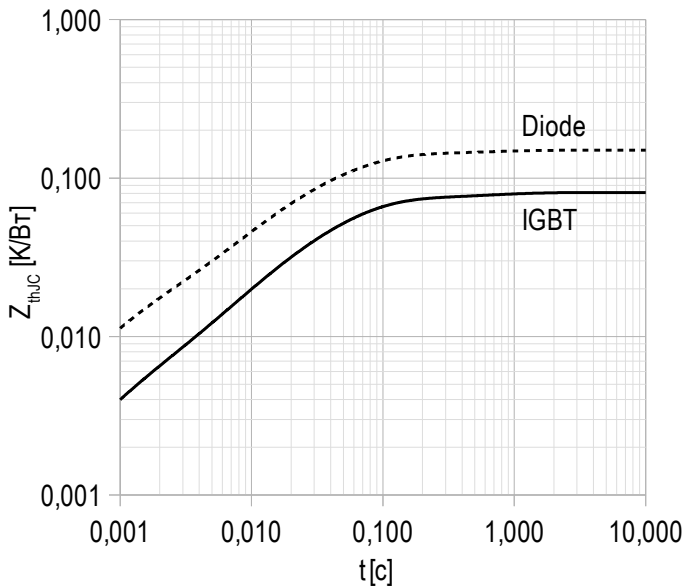
$T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C}$.

Рисунок 5 – типичное время переключения от тока коллектора, IGBT.


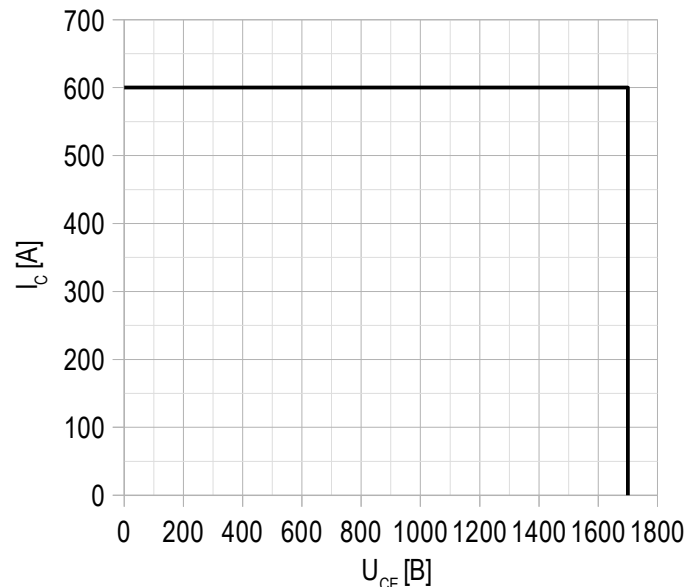
$U_{CE} = 920$ В;
 $U_{GE} = \pm 15$ В;
 $R_G = 3$ Ом;
 $L = 100$ мкГн;
 $T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C}$.

Рисунок 6 – типичное время переключения от сопротивления в затворе, IGBT.


$U_{CE} = 920$ В;
 $U_{GE} = \pm 15$ В;
 $I_{Cmax} = 300$ А;
 $L = 100$ мкГн;
 $T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C}$.

Рисунок 7 – максимальное переходное тепловое сопротивление.


Единичный импульс;
 $U_{GE} = +15$ В.

Рисунок 8 – область безопасной работы при выключении.


$U_{CEmax} = 1700$ В;
 $U_{GE} = \pm 15$ В;
 $I_{Cmax} = 2 \cdot I_{Cnom}$;
 $R_G = 3$ Ом;
 $L = 100$ мкГн.

Рисунок 9 – типичная прямая характеристика, FRD.

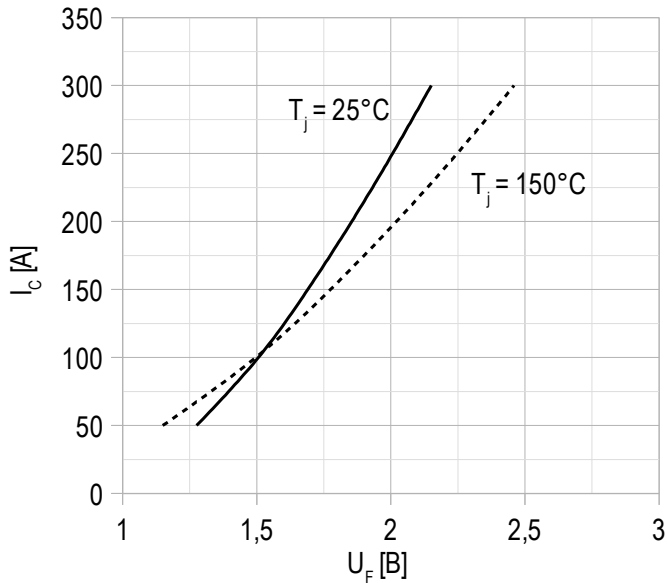

 $U_{GE} = +15 \text{ В.}$

Рисунок 10 – типичная энергия рассеиваемая при восстановлении от тока коллектора, FRD.

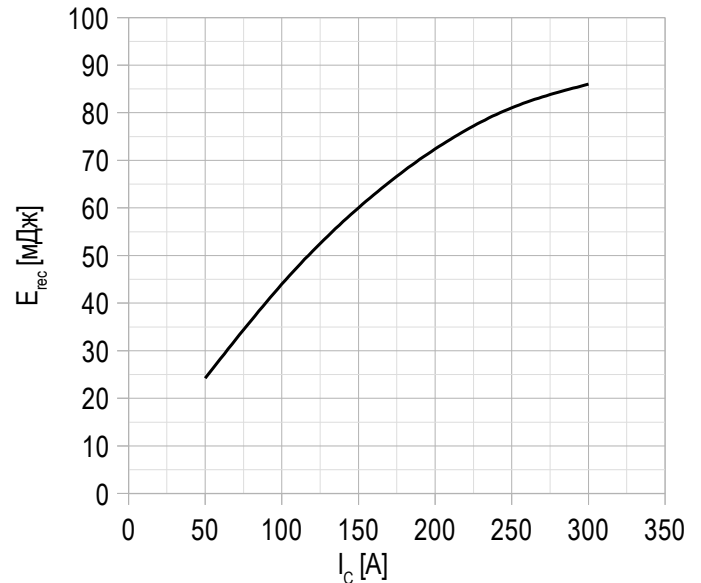

 $U_{GE} = \pm 15 \text{ В;}$
 $U_{CE} = 920 \text{ В;}$
 $L = 100 \text{ мкГн;}$
 $R_{G\ on} = 3 \text{ Ом;}$
 $T_{vj\ (max)} = 150^\circ\text{C.}$

Рисунок 11 – типичная энергия рассеиваемая при восстановлении от сопротивления в затворе, FRD.

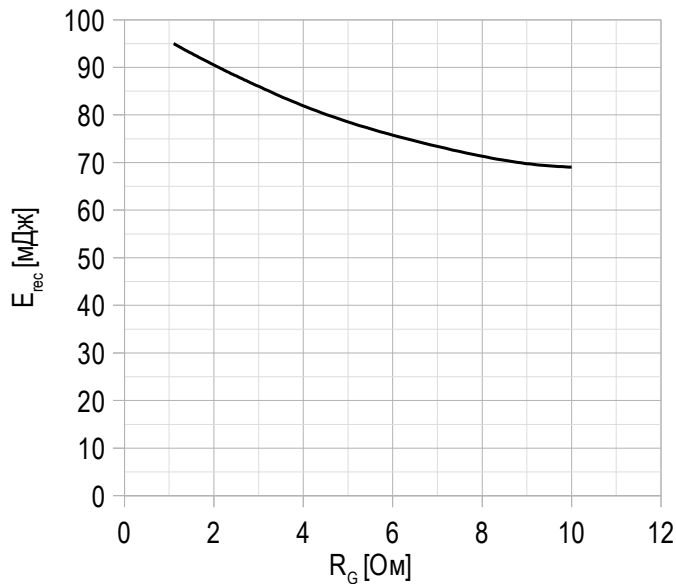

 $U_{GE} = \pm 15 \text{ В;}$
 $U_{CE} = 920 \text{ В;}$
 $I_{C\ max} = 300 \text{ А;}$
 $L = 100 \text{ мкГн;}$
 $T_{vj\ (max)} = 150^\circ\text{C.}$

Рисунок 12 – типичная зависимость заряда обратного восстановления от сопротивления в затворе, FRD.

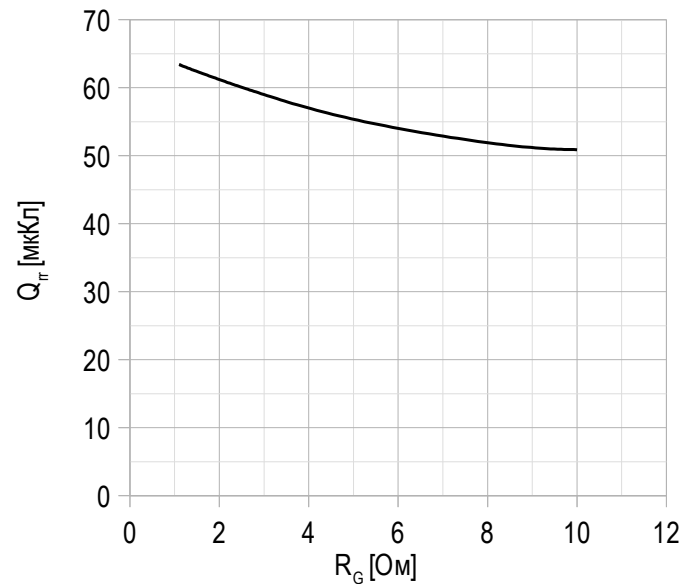
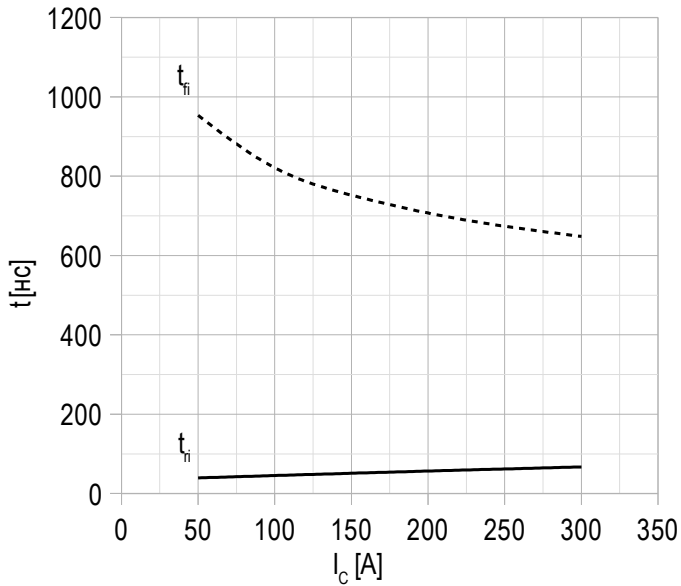
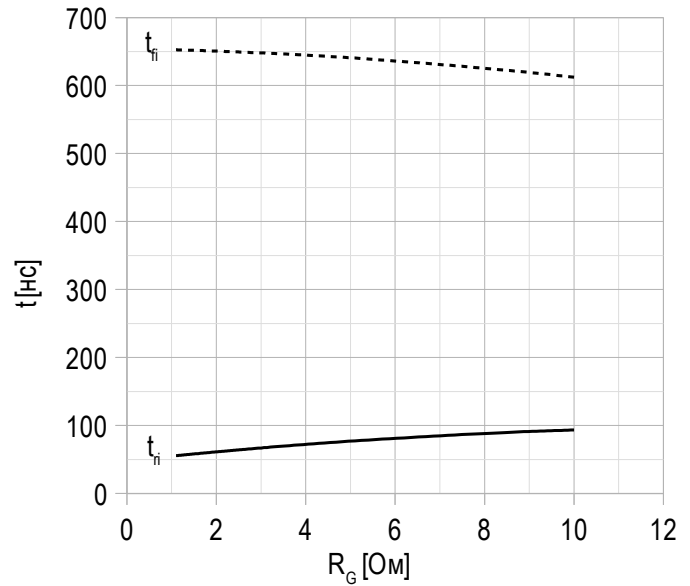
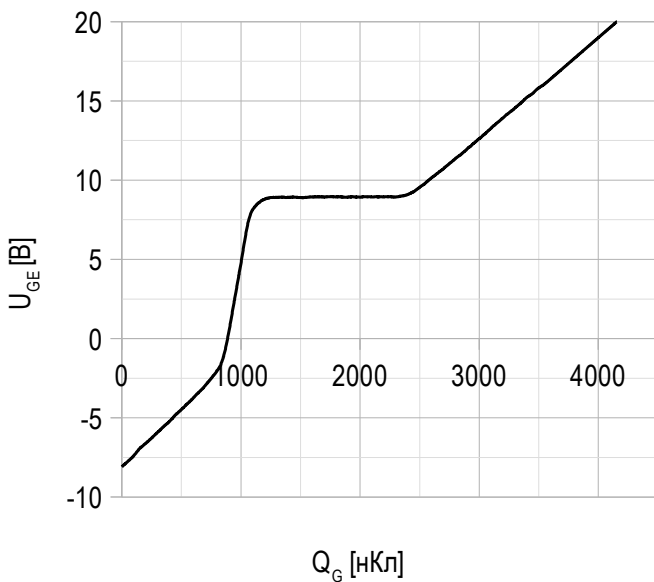

 $U_{GE} = \pm 15 \text{ В;}$
 $U_{CE} = 920 \text{ В;}$
 $I_{C\ max} = 300 \text{ А;}$
 $L = 100 \text{ мкГн;}$
 $T_{vj\ (max)} = 150^\circ\text{C.}$

Рисунок 13 – типичное время переключения от тока коллектора, FRD.


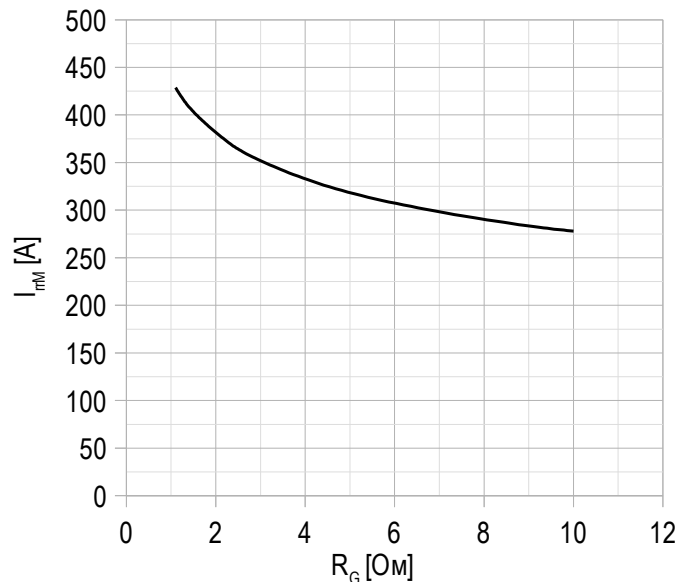
$U_{CE} = 920$ В;
 $U_{GE} = \pm 15$ В;
 $R_G = 3$ Ом;
 $L = 100$ мкГн.
 $T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C}$.

Рисунок 14 – типичное время переключения от сопротивления в затворе, FRD.


$U_{CE} = 920$ В;
 $U_{GE} = \pm 15$ В;
 $I_{Cmax} = 300$ А;
 $L = 100$ мкГн.
 $T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C}$.

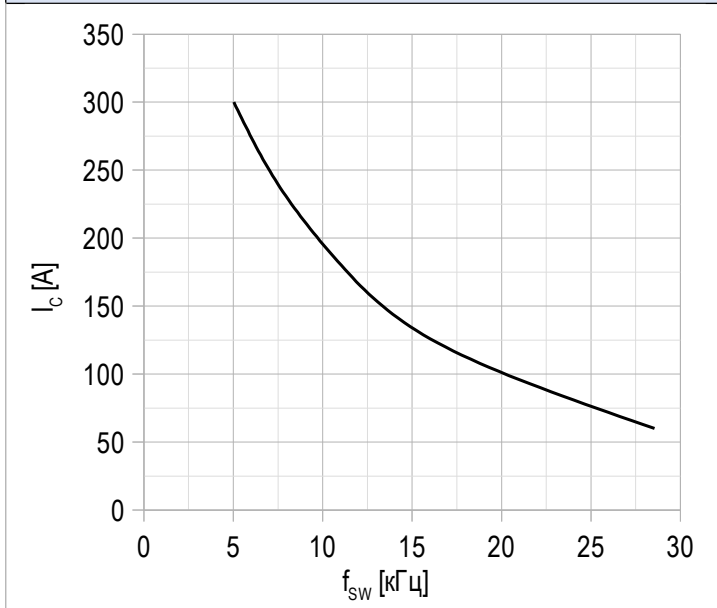
Рисунок 15 – типичная характеристика заряда затвора.


$I_C = 300$ А;
 $U_{CE} = 920$ В;
 $U_{GE} = -8 \div 15$ В.

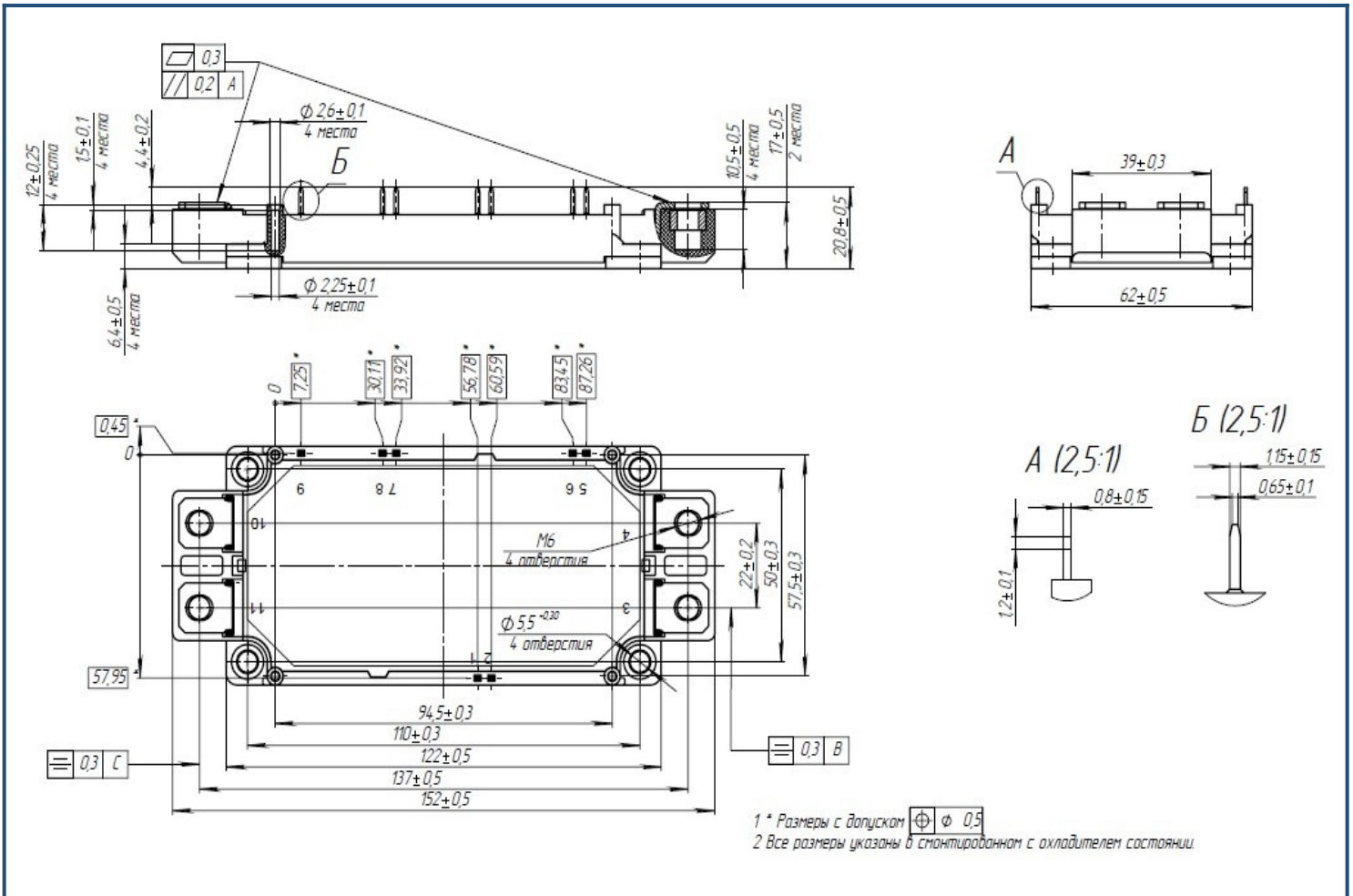
Рисунок 16 – типичная зависимость тока обратного восстановления от сопротивления в затворе, FRD.


$U_{CE} = 920$ В;
 $U_{GE} = \pm 15$ В;
 $L = 100$ мкГн.
 $T_{vj(max)} = 150^\circ\text{C}$.

Рисунок 17 – типичная зависимость тока коллектора от частоты.



Скважность 50%

Габаритные размеры: тип корпуса – DA

Руководство по маркировке

MIDA	-	HB	17	FA	-	300	N	
MIDA								Тип корпуса IGBT модуля: DA
		HB						Полумост
			17					Номинальное напряжение ($U_{CES}/100$)
				FA				IGBT+FRD модификация чипсета
						300		Средний ток
							N	Климатическое исполнение: умеренный климат

Информация, содержащаяся в данном документе, защищена авторским правом. В интересах улучшения качества продукта АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право вносить изменения в информационные листы без предварительного уведомления.